

## WIRING BOARD

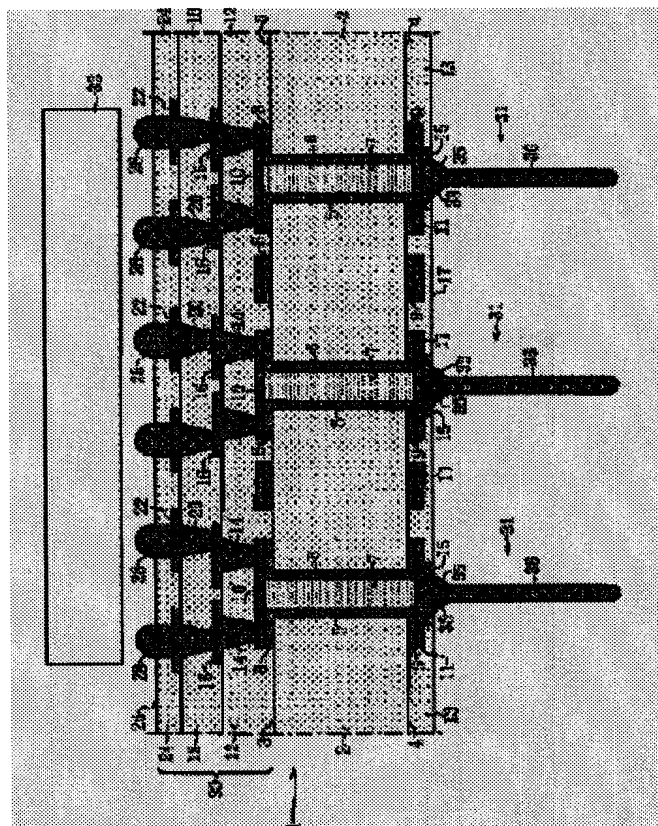
Publication number: JP2003008219  
Publication date: 2003-01-10  
Inventor: OTA SUMIO; KIMURA YUKIHIRO  
Applicant: NGK SPARK PLUG CO  
Classification:  
- international: **H05K3/46; H05K3/46; (IPC1-7): H05K3/46**  
- European:  
Application number: JP20010185341 20010619  
Priority number(s): JP20010185341 20010619

Report a data error here

### Abstract of JP2003008219

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a wiring board, where conductive pins provided upright on its second primary surface are arranged at a narrow pitch, and the conductive connection pins and through-hole conductors penetrating through a core board are improved in electrical properties among them.

**SOLUTION:** A wiring board 1 is equipped with a core board 2 with a top surface 3 and a back surface 4, a build-up layer 30 formed above the top surface of the core board 2, through-holes 5 penetrating through the top surface 3 and back surface 4 of the core board 2, and through-hole conductors 6 each formed on the inner wall of the through-holes 5. A plated layer 11 is formed on the ends of the through-hole conductors 6 on the back surface of the core board 2, and conductive pins 31 are connected by soldering (35) to the back surface of such a plated layer 11, so as to be nearly a concentric axis with that of the through-holes 5.



(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-8219

(P2003-8219A)

(43) 公開日 平成15年1月10日 (2003.1.10)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 5 K 3/46

識別記号

F I

H 0 5 K 3/46

テマコード\* (参考)

N 5 E 3 4 6

B

Q

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2001-185341 (P2001-185341)

(22) 出願日 平成13年6月19日 (2001.6.19)

(71) 出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72) 発明者 太田 純雄

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(72) 発明者 木村 幸広

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(74) 代理人 100098615

弁理士 鈴木 学

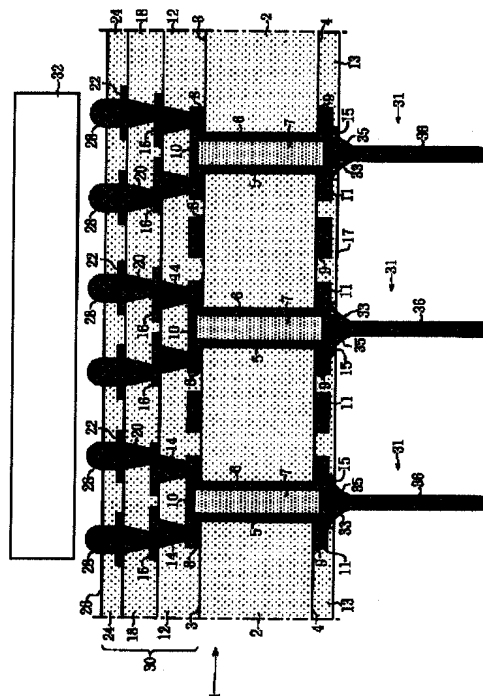
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 配線基板

## (57) 【要約】

【課題】第2主面側に突設する導電性のピンを狭ピッチで配置でき且つかかる接続ピンとコア基板を貫通するスルーホール導体との間の電気的特性を良好ならしめ得る配線基板を提供する。

【解決手段】表面3および裏面4を有するコア基板2と、かかるコア基板2の表面3上方に形成したビルドアップ層30と、上記コア基板2における表面3と裏面4との間を貫通するスルーホール5と、当該スルーホール5の少なくとも内壁表面に形成されたスルーホール導体6と、を備え、かかるスルーホール導体6におけるコア基板2の裏面4側の端部にはメッキ層11が形成されると共に、かかるメッキ層11の裏面側に導電性のピン31が上記スルーホール5とほぼ同軸心にしてハンダ(35)付けなどにより接続されている、配線基板1。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】表面および裏面を有するコア基板と、上記コア基板の表面上方に形成したビルドアップ層と、上記コア基板における表面と裏面との間を貫通するスルーホールと、当該スルーホールの少なくとも内壁表面に形成されたスルーホール導体と、を備え、上記スルーホール導体におけるコア基板の裏面側の端部にはメッキ層が形成されると共に、かかるメッキ層の裏面側に導電性のピンが上記スルーホールとほぼ同軸心にして接続されている、ことを特徴とする配線基板。

【請求項2】前記スルーホール導体における前記コア基板の裏面側の端部にはかかるコア基板の裏面に形成された配線層が接続されていると共に、上記スルーホール導体の裏面側の端部および上記配線層に跨って前記メッキ層が形成されている、ことを特徴とする請求項1に記載の配線基板。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、コア基板の片面(表面)のみにビルドアップ層を有する配線基板に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、図7(A)に示すように、低コスト化の要請によりコア基板の片面(表面)にのみビルドアップ層を形成した配線基板80が求められている。かかる配線基板80は、図7(A)に示すように、絶縁性のコア基板81と、その表面82の上方に形成した配線層88、96、102および絶縁層92、98、104を交互に積層して形成したビルドアップ層と、コア基板81の裏面83の下方に形成した配線層87および絶縁層(ソルダーレジスト層)91と、を備えている。上記コア基板81は、その表面82と裏面83との間を貫通するスルーホール84内にスルーホール導体85および充填樹脂86を形成している。スルーホール導体85は、その上端で配線層88と、下端で配線層87とそれぞれ接続されている。また、充填樹脂86の上端と下端とは、メッキ層90、89により蓋メッキされ、かかるメッキ層90、89は、配線層88、87の一部を形成する。

【0003】図7(A)に示すように、コア基板81の表面82上方でビルドアップ層を形成している配線層88、96、102間は、絶縁層92、98に形成したフィールドビア導体94、100により接続される。また、最上層の配線層102上の所定の位置には、最上層の絶縁層(ソルダーレジスト層)104を貫通し、且つ第1主面106よりも高く突出するハンダバンプ108が複数形成されている。これらのハンダバンプ108は、第1主面106上に搭載する図示しないICチップの接続端子と個別に接続される。

【0004】一方、図7(A)に示すように、コア基板81の裏面83の下方に形成した絶縁層91には、第2主

面93側に開口する開口部95が形成されている。図6(B)に示すように、開口部95の底部には配線層87およびメッキ層89から延びた配線97、99が露出する。かかる配線97、99には、ハンダ101を介して導電性のピン(接続端子)103が接続される。即ち、ピン103の上端の大径部105を配線99に接触した状態で、かかる大径部105と配線99とをハンダ101により接合している。上記ピン103は、配線基板80を搭載する図示しないマザーボードやインターポーザとの接続に用いられる。

【0005】しかしながら、配線基板80では、図7(B)に示すように、スルーホール導体85とピン103とを左右方向にずらして形成しているため、第2主面93側に配置すべき複数のピン103同士間のピッチ(間隔)が制限される。この結果、所要数のピン103を配置できない、という問題があった。また、スルーホール導体85とピン103との間には、配線層87などから延びる配線97、99が位置しているため、両者間の距離が長くなる。このため、スルーホール導体85とピン103との間で、抵抗やループインダクタンスが生じるなどの電気的特性の低下を招く、という問題もあった。

【0006】

【発明が解決すべき課題】本発明は、以上により説明した従来の技術における問題点を解決し、一方の面(第2主面)側に突設する導電性のピンを狭ピッチで配置でき且つかかるピンとコア基板を貫通するスルーホール導体との間の電気的特性を良好ならしめ得る配線基板を提供する、ことを課題とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するため、コア基板を貫通するスルーホール導体と第2主面側に突設する導電性のピンとの距離を可及的に縮小すること、に着想して成されたものである。即ち、本発明の配線基板(請求項1)は、表面および裏面を有するコア基板と、上記コア基板の表面上方に形成したビルドアップ層と、上記コア基板における表面と裏面との間を貫通するスルーホールと、当該スルーホールの少なくとも内壁表面に形成されたスルーホール導体と、を備え、かかるスルーホール導体におけるコア基板の裏面側の端部にはメッキ層が形成されると共に、かかるメッキ層の裏面側に導電性のピンが上記スルーホールとほぼ同軸心にして接続されている、ことを特徴とする。

【0008】これによれば、平面視において、スルーホール導体と導電性のピンとがほぼ同軸心に位置し且つ最短距離で導通することになる。この結果、配線基板の第2主面側に所要数のピンを狭ピッチで配置できるため、配線の高密度化や高性能化の要請に容易に対応することが可能となる。また、スルーホール導体と導電性のピンとが最短距離で導通するため、両者間における抵抗やループインダクタンスが生じにくくなるなどの電気的特性

を向上させることも可能となる。尚、コア基板には、単一の絶縁板の他、複数の絶縁層とこれらの間に位置する配線層とからなる多層配線基板の形態なども含まれる。また、スルーホール導体は、スルーホールの内側全体を導電材で埋め尽くす形態でも良い。更に、上記メッキ層には、コア基板の裏面に形成した配線層が兼ねる形態も含まれる。加えて、上記導電性のピンは、大径部の頂面が球面状のものも含み、Cu-2.3wt%Fe-0.03wt%Pなどの銅系合金または鉄系合金からなる。且つ、かかるピンの接続には、Sn-Sb系、Sn-Ag系、Sn-Ag-Cu系、Pb-Sn系、Sn-Cu系、Sn-Zn系などの低融点合金のハンダ(ろう材)が用いられる。尚また、本発明において、ビルドアップ層とは、比較的厚肉のコア基板の表面上方に交互に形成された複数の絶縁層および複数の配線層を指称する。

【0009】また、本発明には、前記スルーホール導体における前記コア基板の裏面側の端部にはかかるコア基板の裏面に形成された配線層が接続されていると共に、上記スルーホール導体の裏面側の端部および上記配線層に跨って前記メッキ層が形成されている、配線基板(請求項2)も含まれる。これによれば、スルーホール導体の裏面側の端部に接続する配線層にメッキ層を形成し、かかるメッキ層の裏面側に導電性のピンをハンダ付けすることにより、スルーホール導体と上記ピンとを平面視でほぼ同軸心にして配置し且つ両者間を最短距離にて確実に導通させることができる。しかも、上記メッキ層は、スルーホール導体の内側に充填される充填樹脂を密封すると共に、かかる充填樹脂の直下の位置を上記ピンとの接続用に有効活用することもできる。

【0010】付言すれば、本発明には、前記導電性のピンは、その一端に大径部を有すると共に、かかる大径部が前記メッキ層にハンダ付けされている、配線基板を含めことも可能である。これによる場合、上記ピンとメッキ層とを広い面積で面接触させた状態でハンダ付けできるため、かかるピンを確実にメッキ層にハンダ付けなどで接続できると共に、ハンダ付け作業も少ないハンダなどにより容易に行うことが可能となる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下において本発明の実施に好適な形態を図面と共に説明する。図1は、本発明の配線基板1の主要部における断面を示す。配線基板1は、図1に示すように、比較的厚肉のコア基板2と、その表面3の上方に形成したビルドアップ層30と、コア基板2の裏面4の下方に形成した配線層9および絶縁層13と、を備えている。コア基板2は、ガラス-エポキシ樹脂からなり厚みが約0.8mmで平面視でほぼ正方形を呈する絶縁板である。かかるコア基板2には、その表面3と裏面4との間を貫通する直径約250μmの複数のスルーホール5が穿孔され、かかるスルーホール5の内壁表面に沿って、銅メッキからなる厚みが数10μmのスル

ーホール導体6およびその内側の充填樹脂7がそれぞれ形成されている。

【0012】図1に示すように、コア基板2の表面3には、所定パターンの銅メッキの配線層8が形成され、かかる配線層8はスルーホール導体6の上端と接続されている。また、充填樹脂7の上端およびスルーホール導体6の上端と接続する配線層8の上には、充填樹脂7を蓋メッキする銅メッキ層(メッキ層)10が形成される。かかる銅メッキ層10は、配線層8の一部を形成している。かかる配線層8を含むコア基板2の表面3の上には、シリカフィラなどの無機フィラを含むエポキシ樹脂からなる絶縁層12、18、24と銅メッキからなる配線層16、22とが交互に積層され、配線層8と共にビルドアップ層30を形成している。尚、絶縁層12、18の厚みは約30μmで、最上層の絶縁層(ソルダーレジスト層)24の厚みは約25μmで、配線層8、16、22の厚みは約15μmである。

【0013】図1に示すように、絶縁層12、18には、配線層8、16、22間を導通するフィルドビア導体14、20が形成されている。また、最上層の配線層22の上には、絶縁層24を貫通し且つ配線基板1の表面である第1主面26よりも高く突出する複数のハンダバンプ(IC接続端子)28が形成されている。かかるハンダバンプ28は、第1主面26上に実装するICチップ(半導体素子)32の底面に形成された図示しない接続端子と個別に接続される。かかる接続端子と各バンプ28とは、図示しないアンダーフィル材により埋設され且つ保護される。尚、上記ハンダバンプ28は、Sn-Ag系、Sn-Ag-Cu系、Pb-Sn系、Sn-Cu系、Sn-Zn系などの低融点合金(本実施形態では、Sn-Ag系のハンダ)から形成される。

【0014】図1のように、コア基板2の裏面4には、所定パターンの配線層(メッキ層)9が形成され、かかる配線層9はスルーホール導体6の下端(端部)と接続されている。また、充填樹脂7の下端およびスルーホール導体6の下端と接続する配線層9の下側には、充填樹脂7を蓋メッキする銅メッキ層(メッキ層)11が形成される。即ち、銅メッキ層11は、スルーホール導体6の下端と配線層9とに跨って形成されると共に、配線層9の一部を形成する。かかる配線層9を含むコア基板2の裏面4の下には、シリカフィラなどの無機フィラを含むエポキシ樹脂からなり且つ厚みが約25μmの絶縁層(ソルダーレジスト層)13が形成される。

【0015】図1に示すように、絶縁層13における各スルーホール導体6の真下の位置には、第2主面17側に開口する開口部15がそれぞれ形成される。開口部15の底部には、配線層9を形成している銅メッキ層11が露出する。この銅メッキ層11の表面には、防錆のため図示しないNiおよびAuメッキ膜が被覆される。開口部15の底部に露出する配線層9の銅メッキ層11の

裏面側には、導電性のピン31上端の大径部33がハンダ35によりハンダ付け(接続)される。上記ピン31は、例えばCu-2.3wt%Fe-0.03wt%Pの銅系合金(いわゆる194合金)からなり、大径部33(厚み0.2mm×直径0.6mm)および棒状の先端部36(長さ3mm×直径0.45mm)により構成される。また、ハンダ35には、Sn-Sb系、Sn-Ag系、Sn-Ag-Cu系、Pb-Sn系、Sn-Cu系、Sn-Zn系などの低融点合金のハンダ(ろう材)が用いられる。

【0016】図1に示すように、各ピン31と各スルーホール5とは、互いに同軸心にして配置(スルーホール5の中心軸とピン31の棒状の先端部36の長手方向の中心軸とがほぼ同軸)され、且つ各ピン31と各スルーホール導体6の間には配線層9の銅メッキ層(メッキ層)11のみが存在している。このため、各ピン31と各スルーホール導体6と最短距離で導通できるので、配線基板1の第2主面17側に所要数のピン31を狭ピッチで配置できる。しかも、スルーホール導体6と導電性のピン31とが最短距離で導通するため、両者間における抵抗やループインダクタンスが生じにくくなるなどの電気的特性を向上させることも可能となる。また、ピン31やスルーホール導体6を介して、ビルドアップ層30の配線層16などとマザーボードやインターポーザとの導通も容易となる。従って、配線基板1によれば、内部配線の高密度化や高性能化の要請に対応することが可能となる。

【0017】以下において、以上の配線基板1の製造方法を図2～図4により説明する。図2(A)は、厚みが約800μmのコア基板2の断面を示し、その表面3と裏面4とは、厚みが約15μmの銅箔3a、4aが全面に貼り付けてある。かかるコア基板2における所定の位置に対し、その厚み方向に沿ってドリルの挿入またはレーザー(炭酸ガスレーザーなど)の照射を行う。その結果、図2(B)に示すように、コア基板2において、その表面3と裏面4との間を貫通する直径約250μmのスルーホール5が複数穿孔される。次に、各スルーホール5の内壁に予めPdなどを含むメッキ触媒を付着した後、コア基板2の全面に対し無電解銅メッキおよび電解銅メッキを施す。

【0018】その結果、図2(C)に示すように、各スルーホール5の内壁表面に沿ってスルーホール導体6が形成される。尚、前記銅箔3a、4aは上記銅メッキによって更に厚くなるが便宜上図2(B)と同じ厚きとする。次に、図2(D)に示すように、各スルーホール導体6の内側に、シリカフィラなどの無機フィラを含むエポキシ樹脂からなる充填樹脂7を充填して形成する。次いで、図3(A)に示すように、銅箔3a、4aの上に無電解銅メッキおよび電解銅メッキを施して、銅メッキ層3b、4bを形成する。この結果、充填樹脂7の上端および下

端は、銅メッキ層3b、4bにより蓋メッキされる。

【0019】かかる状態で、銅メッキ層3b、4bの上に所定のパターンを有する図示しないエッチングレジストを形成した後、かかるレジストの隙間から露出する銅メッキ層3b、4bおよび銅箔3a、4aをエッチングして除去する公知のサブトラクティブ法を施す。その結果、図3(B)に示すように、コア基板2の表面3および裏面4には、上記レジストのパターンに倣った所定パターンの配線層8、9と、これらに積層され且つその一部となる銅メッキ層10、11とが形成される。次に、図3(C)に示すように、コア基板2の表面3と裏面4に、シリカフィラなどの無機フィラを含むエポキシ樹脂からなり厚みが約30μmまたは25μmの絶縁層12、13を形成する。

【0020】次いで、図4(A)に示すように、表面3側の絶縁層12の所定の位置に対しレーザーを照射して、円錐形状のビアホール14aを形成すると共に、その底面に銅メッキ層10を露出させる。また、裏面4側の絶縁層(ソルダーレジスト層)13に公知のフォトリソグラフィ技術を施し、各スルーホール導体6の真下に位置する銅メッキ層11を底面に露出させる開口部15を形成する。また、ビアホール14a内と絶縁層12の表面上に図示しない銅メッキ層を形成し且つその上に前記同様のエッチングレジストの形成した後、エッチングすることにより、図4(B)に示すように、フィールドビア導体14および配線層16が形成される。上記ビア導体14の下端は配線層8の銅メッキ層10と接続する。

【0021】更に、図4(B)に示すように、各開口部15に露出する配線層9の銅メッキ層11には、予めその表面にNiおよびAuメッキが施された後、溶融したSn-Sb系合金からなるハンダ35が載置される。かかるハンダ35に対し、前記の銅系合金からなる導電性のピン31の大径部33を接近させ且つ挿入する。その結果、図4(C)に示すように、上記ピン31は、ハンダ35を介して配線層9の銅メッキ層11と接続される共に、直上のスルーホール導体6と同軸心で且つ最短距離の位置に配置される。

【0022】また、図4(C)に示すように、絶縁層12および配線層16の上に絶縁層18を形成する。これ以降は、配線層8、16や絶縁層12、18と共に前記ビルドアップ層30を形成する前記絶縁層24、配線層22、およびビア導体20を、公知のビルトアップ技術(セミアディティブ法、フルアディティブ法、サブトラクティブ法、フィルム状樹脂材料のラミネートによる絶縁層の形成、フォトリソグラフィ技術など)により形成する。最後に前記ハンダバンプ(1C接続端子)28を形成することにより、前記図1に示した配線基板1を得ることができる。尚、以上のような図2(A)～図4(C)に示した製造工程は、複数のコア基板2(製品単位)を平面方向に併有する多数個取りの基板(パネル)にて行っても

良い。

【0023】図5は、異なる形態の配線基板40における主要部の断面を示す。配線基板40は、図5に示すように、比較的薄肉の第1の絶縁層42と比較的厚肉の第2の絶縁層44とを接着層(プリプレグ)46により積層した多層基板のコア基板41、かかるコア基板41における表面43の上方に交互に形成された配線層56、64、72と絶縁層60、66、70とを含むビルドアップ層71、およびコア基板41に形成された凹部52と、を備えている。コア基板41を形成する第1の絶縁層42は、厚みが100~400 $\mu$ mのガラス-エポキシ樹脂からなり、その中央付近には、直径約150 $\mu$ mの複数のスルーホール53が貫通し、各スルーホール53の内壁に沿って、厚みが約25 $\mu$ mで銅製のスルーホール導体54および充填樹脂55が形成されている。

【0024】図5に示すように、第2の絶縁層44は、厚みが約800 $\mu$ mのガラス-エポキシ樹脂からなり、その中央付近にはコア基板41の裏面45側に開口する凹部52が穿設されている。かかる凹部52は、平面視で縦・横約14mmずつのほぼ正方形を呈する。第1の絶縁層42と第2の絶縁層44とは、ガラスクロスを含む厚みが約60 $\mu$ mの接着層(プリプレグ)46を介して貼り合わせて積層されると共に、これらにより、コア基板41が形成されている。図5の左右に示すように、凹部52を除いた位置におけるコア基板41の第1の絶縁層42および第2の絶縁層44には、直径約150 $\mu$ mで比較的長い複数のスルーホール47が貫通し、各スルーホール47の内壁に沿って厚みが約25 $\mu$ mで銅製のスルーホール導体48および充填樹脂49が形成されている。

【0025】また、図5に示すように、第1の絶縁層42の裏面には、所定パターンを有し銅製で且つ厚みが約15 $\mu$ mで銅製の配線層50が形成される。更に、凹部52の底部に位置する配線層(電子部品接続端子)50は、スルーホール導体54の下端と接続し、且つ充填樹脂49を蓋メッキする導体層73を含んでいる。一方、接着層46の上側に位置する配線層50は、スルーホール導体48の中間と接続している。第2の絶縁層44の表面側における接着層46の下側にも、所定パターンおよび厚みを有する銅製の配線層51が形成され、且つスルーホール導体48の中間と接続されている。

【0026】更に、図5に示すように、コア基板41の表面43には、所定パターンを有する銅製の配線層56が形成され、スルーホール導体48、54の上端と接続されている。かかる配線層56は、スルーホール導体48、54の上端(端部)を蓋メッキする銅メッキ層(メッキ層)58を含んでいる。コア基板41の表面43および配線層56の上には、シリカフィラを含むエポキシ系樹脂の絶縁層60が形成され、且つ配線層56上の所定の位置にフィルドビア導体62が形成されている。絶縁

層60の上には、同様の絶縁層66および上記ビア導体62の上端と接続する配線層64が形成されると共に、かかる配線層64上の所定の位置にフィルドビア導体68が形成されている。同様に、上記絶縁層66の上には、絶縁層(ソルダーレジスト層)70および上記ビア導体68の上端と接続する配線層72が形成される。以上の絶縁層60、66、70および配線層56、64、72は、ビルドアップ層71を形成する。

【0027】図5に示すように、配線層72上の所定の位置には、第1主面(表面)74よりも高く突出する複数のハンダバンプ(IC接続端子)76が形成され、かかるバンプ76は、第1主面74上に実装するICチップ(半導体素子)78の底面における図示しない接続端子と個別に接続される。かかるバンプ76は、前記同様の低融点合金からなり、複数のハンダバンプ76とICチップ78の各接続端子とは、図示しないアンダーフィル材により埋設され且つ保護される。

【0028】また、図5に示すように、第1・第2の絶縁層42、44により形成される凹部52には、複数のチップコンデンサ(電子部品)77が挿入され且つハンダ75を介して実装される。このコンデンサ77は、両側面の上端に突出する電極79を図5の前後方向に沿って複数有し、例えばチタン酸バリウムを主成分とする誘電層および内部電極となるNi層を交互に積層したセラミックコンデンサであり、3.2mm×1.6mm×0.7mmのサイズを有する。かかるコンデンサ77における上端の電極79は、ハンダ75を介してスルーホール導体54の下端に位置し且つ凹部52内に露出する配線層50の銅メッキ層73と接続される。尚、上記ハンダ75も、低融点合金(Sn-Sb系ハンダなど)からなる。

【0029】更に、図5に示すように、コア基板41の裏面45と配線層57との下には、凹部52の真下を除いて前記同様の厚みを有する絶縁層(ソルダーレジスト)61が形成される。配線層57は、スルーホール導体48の下端(端部)と接続し、且つ充填樹脂49の下端を蓋メッキする銅メッキ層(メッキ層)59を含んでいる。スルーホール導体48および配線層57のほぼ真下における絶縁層61には、第2主面61a側に開口する開口部63が形成され、その底部に配線層57の銅メッキ層59が露出する。かかる銅メッキ層59の表面には、図示しないNiおよびAuメッキ膜が被覆される。開口部63の底部に露出する配線層57の銅メッキ層59の裏面側には、前記同様の銅系合金からなる導電性のピン65がハンダ付け(接続)される。具体的には、ピン65の上端に位置する大径部67がハンダ69によりハンダ付け(接続)される。

【0030】図5に示すように、各ピン65と各スルーホール47とは、互いに同軸心にして配置される共に、各ピン65と各スルーホール導体48との間には配線層

57の銅メッキ層(メッキ層)59のみが介在している。このため、各ピン65と各スルーホール導体48と最短距離で導通できるので、配線基板40の第2主面61a側に所要数のピン65を狭ピッチで配置できる。しかも、各スルーホール導体48とピン65とが最短距離で導通するため、両者間における抵抗やループインダクタンスが生じにくくなるなどの電気的特性を向上させることも可能となる。また、ピン65やスルーホール導体48を介して、ビルドアップ層71を形成する配線層56などまたは電子部品77とマザーボードやインターポーザとの導通も容易となる。従って、配線基板50によれば、内部配線の高密度化や高性能化の要請に容易に対応することが容易となる。

【0031】図6は、前記導電性のピン31の異なる接続形態を示す。図6に示すように、コア基板2の表面3と裏面4との間を貫通するスルーホール5の内壁表面に沿ってスルーホール導体6が形成され、且つ当該スルーホール導体6の内側には充填樹脂7が前記同様に形成されている。コア基板2の表面3と裏面4とは、スルーホール導体6の上端または下端と接続する配線層(メッキ層)8、9が形成されている。コア基板2の裏面4の下に形成した絶縁層(ソルダーレジスト層)13には、上記スルーホール導体6のほぼ真下の位置に第2主面17側に開口する開口部15が形成され、当該開口部15の底部には上記配線層9および充填樹脂7が露出する。かかる開口部15内の配線層9に対し、図6に示すように、前記同様のハンダ35を介して導電性のピン31を接続する。上記ピン31は、その大径部33の頂面34が球面状であり、ハンダ35が大径部33を包囲している。かかる接続形態では、前記銅メッキ層11を省略できるため、配線基板1の製造工数およびコストが低減できる。尚、図6で示したピン31の接続形態は、前記図5に示した配線基板40にも適用可能である。

【0032】本発明は、以上に説明した各形態に限定されるものではない。前記コア基板2、41の第1・第2絶縁層42、44の材質は、前記ガラス-エポキシ樹脂系の複合材料の他、ビスマレイミド・トリアジン(BT)樹脂、エポキシ樹脂、同様の耐熱性、機械強度、可撓性、加工容易性などを有するガラス織布や、ガラス織布などのガラス繊維とエポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、またはBT樹脂などの樹脂との複合材料であるガラス繊維-樹脂系の複合材料を用いても良い。あるいは、ポリイミド繊維などの有機繊維と樹脂との複合材料や、連続気孔を有するPTFEなど3次元網目構造のフッ素系樹脂にエポキシ樹脂などの樹脂を含浸させた樹脂-樹脂系の複合材料などを用いることも可能である。また、前記スルーホール導体6、メッキ層11、配線層16などの材質は、前記Cuの他、Ag、Ni、Ni-Au系などにしても良く、あるいはこれら金属のメッキ層を用いず、導電性樹脂を塗布するなどの方法により形成しても良

い。

【0033】更に、前記絶縁層12、18などの材質は、前記エポキシ樹脂を主成分とするもののほか、同様の耐熱性、パターン成形性等を有するポリイミド樹脂、BT樹脂、PPE樹脂、あるいは、連続気孔を有するPTFEなど3次元網目構造のフッ素系樹脂にエポキシ樹脂などの樹脂を含浸させた樹脂-樹脂系の複合材料などを用いることもできる。尚、絶縁層の形成には、絶縁性の樹脂フィルムを熱圧着する方法のほか、液状の樹脂をロールコートにより塗布する方法を用いることもできる。尚また、絶縁層に混入するガラス布またはガラスフィラの組成は、Eガラス、Dガラス、Qガラス、Sガラスの何れか、またはこれらのうちの2種類以上を併用したものとしても良い。また、ビア導体は、前記フィールドビア導体14などでなく、完全に導体で埋まってないコンフォーマルビア導体とすることもできる。あるいは、各ビア導体の軸心をずらしつつ積み重ねるスタッガードの形態でも良いし、途中で平面方向に延びる配線層が介在する形態としても良い。

【0034】また、前記凹部52に実装する電子部品は、1つのみでも良い。あるいは、多数の配線基板(製品単位)40を含む多数個取りの基板(パネル)内における製品単位1個内に、複数の凹部52を形成し且つ各凹部52内に所要数の電子部品を実装しても良い。更に、複数のチップ状電子部品を互いの側面間で予め接着したユニットとし、これを前記凹部52内に実装などすることもできる。また、チップ状電子部品には、前記チップコンデンサ77などの他、チップ状のインダクタ、抵抗、フィルタなどの受動部品や、トランジスタ、半導体素子、FET、ローノイズアンプ(LNA)などの能動部品も含まれると共に、互いに異種の電子部品同士を配線基板40の同じ凹部52に併せて実装することも可能である。尚、前記凹部52の底部(天井面)に形成する配線層50を除いて、第1の絶縁層42の裏面と第2の絶縁層44の表面との配線層を形成せず、接着層46を介して第1の絶縁層42と第2の絶縁層44とを直に積層することも可能である。

【0035】

【発明の効果】以上に説明した本発明の配線基板(請求項1)によれば、スルーホールと導電性のピンとがほぼ同軸心に位置し且つスルーホール導体と上記ピンとが最短距離で導通するので、配線基板の第2主面側に所要数のピンを狭ピッチで配置できる。このため、配線の高密度化や高性能化の要請に容易に対応することが可能となる。また、スルーホール導体と導電性のピンとが最短距離で導通するため、両者間における抵抗やループインダクタンスが生じにくくなるなどの電気的特性を向上させることも可能となる。

【0036】また、請求項2の配線基板によれば、スルーホール導体の裏面側の端部に接続する配線層にメッキ

層を形成し、かかるメッキ層の裏面側に導電性のピンをハンダ付けすることにより、スルーホールと上記ピンとを平面視でほぼ同軸心で配置し且つスルーホール導体と上記ピンとの間を最短距離により確実に導通できる。しかも、上記メッキ層は、スルーホール導体の内側に充填される充填樹脂を密封すると共に、かかる充填樹脂の直下の位置を上記ピンとの接続用に活用することもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の配線基板における主要部を示す断面図。

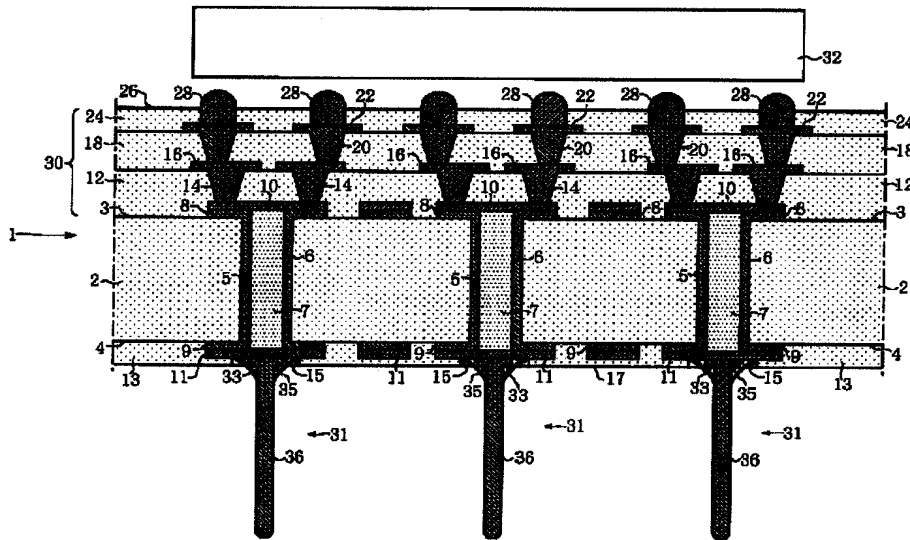
【図2】(A)～(D)は図1の配線基板の製造方法における主な工程を示す概略図。

【図3】(A)～(C)は図2(D)に続く上記製造方法における主な工程を示す概略図。

【図4】(A)～(C)は図3(C)に続く上記製造方法における主な工程を示す概略図。

\*

【図1】



\*【図5】異なる形態の配線基板における主要部を示す断面図。

【図6】導電性のピンの異なる接続形態を示す概略図。

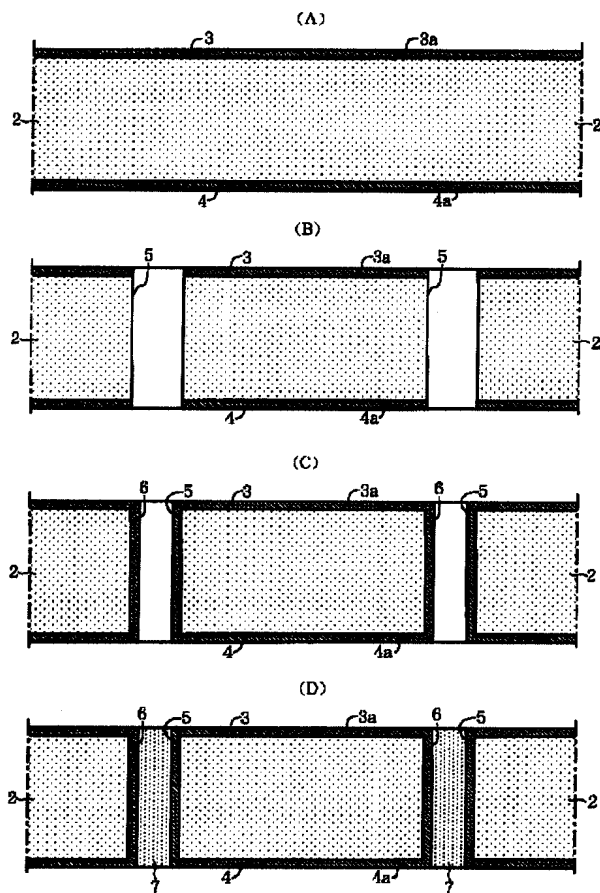
【図7】(A)は従来の配線基板を示す断面図、(B)は(A)中における部分拡大図。

【符号の説明】

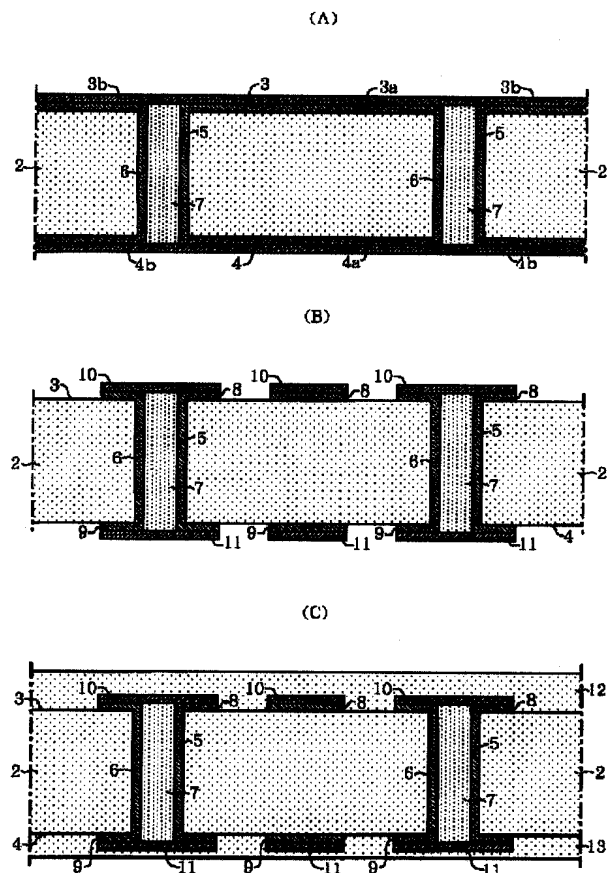
- 1, 40 ……配線基板
- 2, 41 ……コア基板
- 3, 43 ……表面
- 4, 45 ……裏面
- 5, 47 ……スルーホール
- 6, 48 ……スルーホール導体
- 9, 57 ……配線層(メッキ層)
- 11, 59 …銅メッキ層(メッキ層)
- 30, 71 …ビルドアップ層
- 31, 65 …導電性のピン



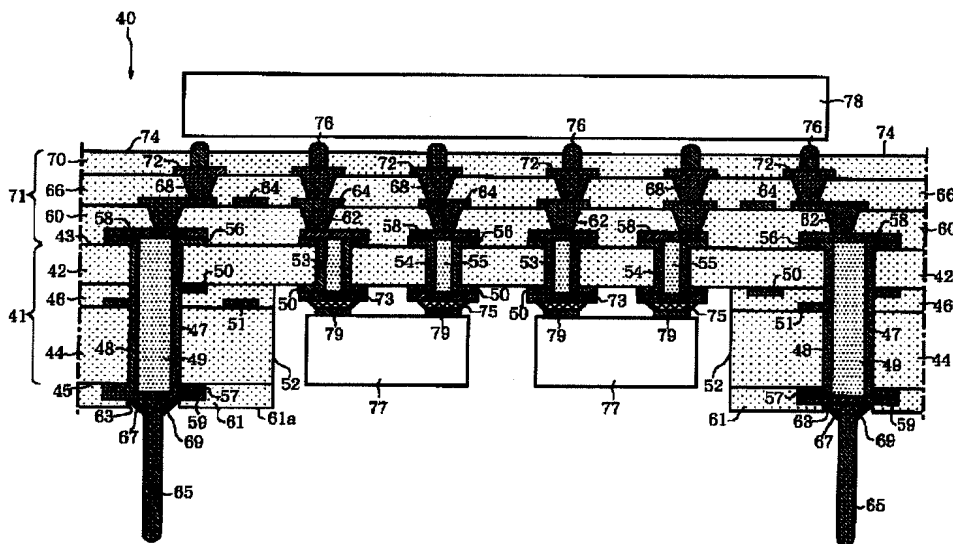
【図2】



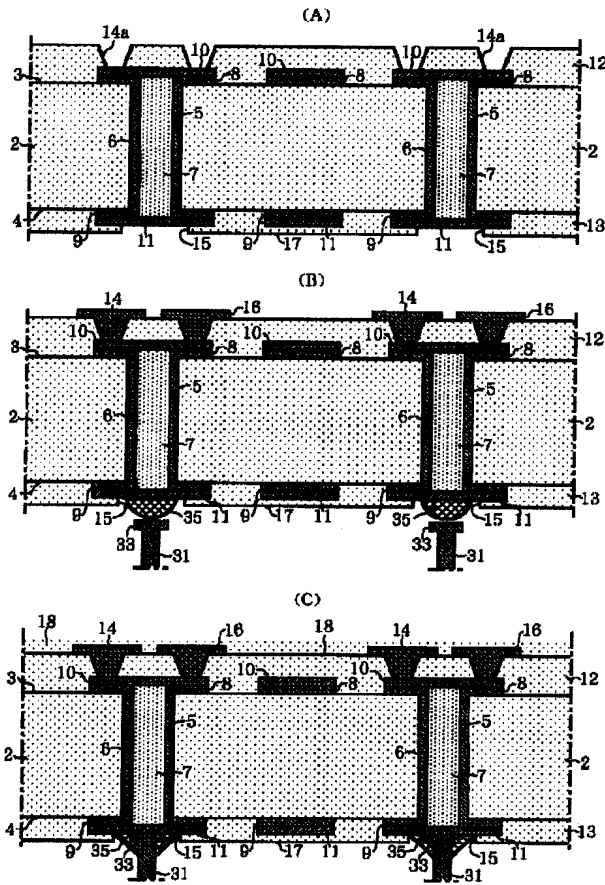
【図3】



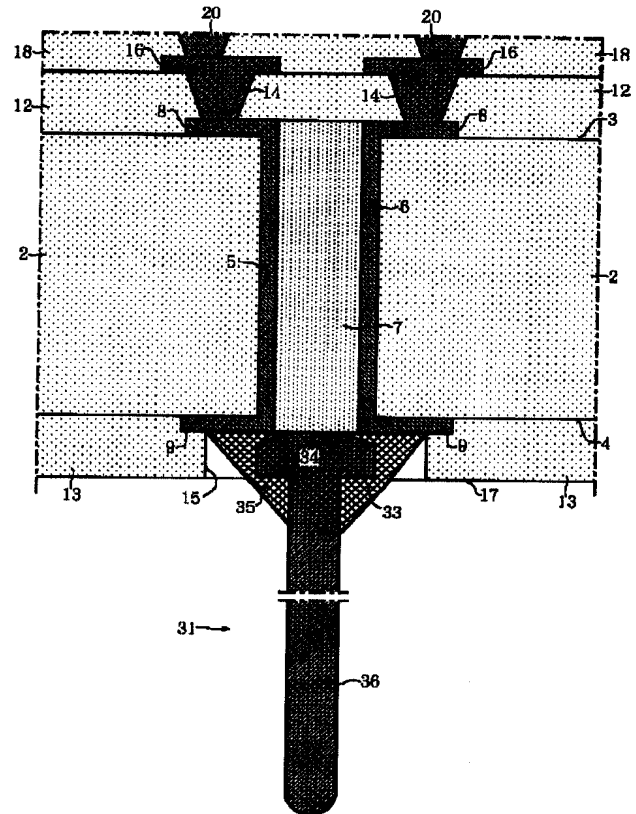
【図5】



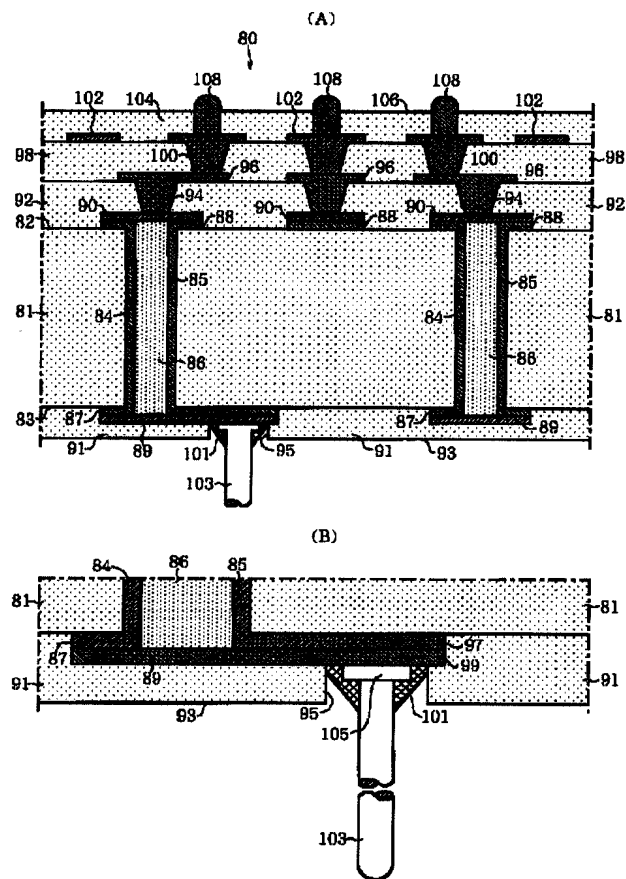
【図4】



【図6】



(A)



F ターム(参考) 5E346 AA06 AA12 AA15 AA32 AA43  
AA51 BB20 DD22 EE06 EE07  
FF01 FF04 FF12 FF33 FF45  
GG15 GG17 GG25 GG28 HH25  
HH26